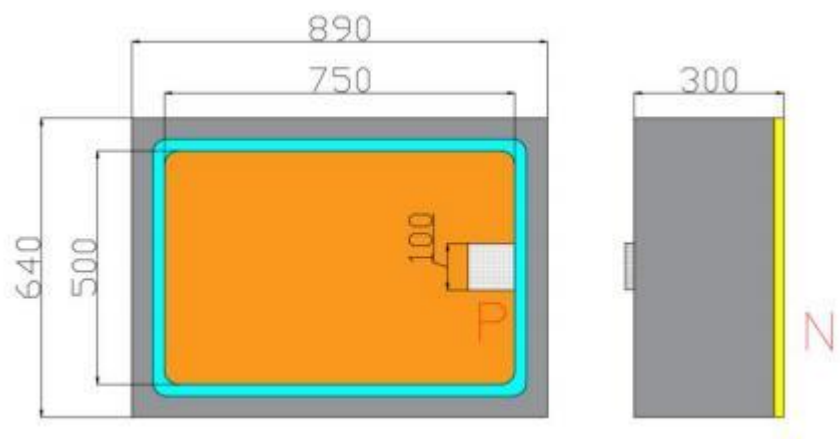


Кремниевый фотодетекторный чип 890×640 мкм — техническое описание

P/N : WS94-01C

Особенности
Si PIN фотодиодный чип

Структура
Планарная структура: PN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) — золото, верхняя сторона (анод) — алюминий



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	750 × 500			мкм
Ширина чипа	640			мкм
Длина чипа	890			мкм
Высота чипа	280	300	320	мкм
Размер контактной площадки		100		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	60			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V, H=0			10	нА
Емкость	Cj	VR=3V, H=0, F=1MHz		10		пФ
Рабочий диапазон длин волн	λ		430		1000	нм
Обратный световой ток	IL	VR=5V, 1 mW/cm2 @940nm		2		мкА